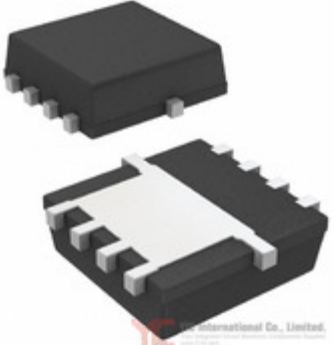

	<h2 style="color: #D9534F;">SI7601DN-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI7601DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 16A 1212-8
	Datenblätter:  SI7601DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

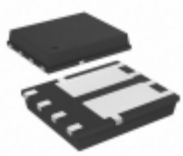



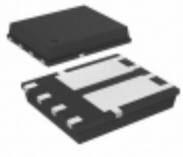


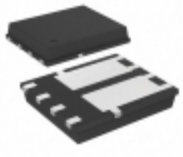
Spezifikationen

Teilenummer	SI7601DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 16A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19.2 mOhm @ 11A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7601DN-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1870pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 16A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SI7601DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7601DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7601DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7601DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7540DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 12V 7.6A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7611DN SI SI7611DN SI</p>	 <p>SI7606DN-T1-E3 VISHAY SI7606DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7606DN-T1-GE3 VB SI7606DN-T1-GE3 VB</p>
 <p>SI7540DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 12V 7.6A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7601DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 16A 1212-8</p>	 <p>SI7601DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 16A 1212-8</p>	 <p>SI7540DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 12V 7.6A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7601DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7601DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7601DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7601DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7601DN-T1-GE3
SI7601DN-T1-GE3 Electronic	SI7601DN-T1-GE3-Komponenten	SI7601DN-T1-GE3-Verteiler	SI7601DN-T1-GE3-Bild	SI7601DN-T1-GE3-Teil
SI7601DN-T1-GE3 Preis	SI7601DN-T1-GE3 Hersteller	SI7601DN-T1-GE3 Bild	SI7601DN-T1-GE3 Aktie	SI7601DN-T1-GE3 Inventar
SI7601DN-T1-GE3 Neu	SI7601DN-T1-GE3 Original	SI7601DN-T1-GE3 garantiert	SI7601DN-T1-GE3 RFQ	SI7601DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited